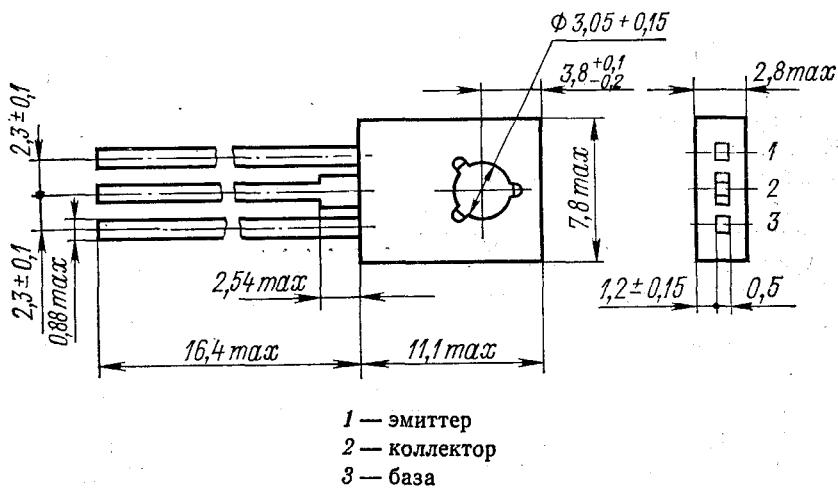


По техническим условиям аА0.336.184 ТУ

Основное назначение — работа в аппаратуре широкого применения.
Оформление — в пластмассовом корпусе.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---------|
| Высота наибольшая (без выводов) | 11,1 мм |
| Ширина наибольшая | 7,8 мм |
| Вес наибольший | 1 г |



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обратный ток коллектора ($U_{KB} = -40$ В):

при $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$

 » $t_{\text{кор}} = 100 \pm 3^\circ \text{C}$

не более 50 мкА

не более 1 мА

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:

при $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10$ и $100 \pm 3^\circ \text{C}$

 » $t_{\text{кор}} = -40 \pm 3^\circ \text{C}$

не менее 40

не менее 30

Граничное напряжение ($I_E = 50$ мА) *

не менее 25 В

KT814A
КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР
p-n-p

| | |
|---|-------------------|
| Граничная частота коэффициента передачи тока ($U_{KB} = -5$ В; $I_E = 30$ мА) | не менее 3 МГц |
| Напряжение насыщения ($I_K = 0,5$ А; $I_B = 50$ мА): коллектор—эмиттер | не более 0,6 В |
| база—эмиттер | не более 1,2 В |
| Емкость перехода на частоте 465 кГц: коллекторного ($U_{KB} = -5$ В) | не более 60 пФ |
| эмиттерного ($U_{EB} = -0,5$ В) | не более 75 пФ |
| Долговечность | не менее 10 000 ч |

* При $t_H \leq 300$ мкс и $Q \geq 100$.**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ***

| | |
|---|------------|
| Наибольшее постоянное напряжение коллектор— эмиттер | минус 25 В |
| Наибольшее постоянное напряжение коллектор— эмиттер при $R_{BE} \leq 100$ Ом | минус 40 В |
| Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база | минус 5 В |
| Наибольший ток коллектора: постоянный | 1,5 А |
| импульсный ($t_H \leq 10$ мс и $Q \geq 100$) | 3 А |
| Наибольший постоянный ток базы | 0,5 А |
| Наибольшая постоянная рассеиваемая мощность кол- лектиора с теплоотводом: при $t_{kor} \leq 25^\circ\text{C}$ | 10 Вт |
| » $t_{kor} = 100^\circ\text{C}$ | 2,5 Вт |
| Наибольшая рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода при $t_{kor} = 25^\circ\text{C}$ | 1 Вт |
| Наибольшая температура перехода | 125° С |

* При $t_{kor} = -40 + 100^\circ\text{C}$.Δ При $t_{kor} = 25 + 100^\circ\text{C}$ наибольшая рассеиваемая мощность снижается по линейному закону.○ При t_{kor} выше 25°C наибольшая мощность снижается линейно на 0,01 В на каж-
дый °С.**УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

| | |
|--|-------------|
| Температура корпуса: наибольшая | плюс 100° С |
| наименьшая | минус 40° С |
| Наибольшая относительная влажность при темпера- туре 40°C | 98% |

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

p-n-p

KT814A
KT814B
KT814B

Давление окружающей среды:

наибольшее 3 ат
наименьшее 203 мм рт. ст.

Наибольшее ускорение:

при вибрации* 10 g
линейное 150 g
при многократных ударах 150 g

* В диапазоне частот 1—600 Гц.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается пайка и изгиб выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса с радиусом закругления 1,5—2 мм и без передачи усилия на корпус транзистора.

Гарантийный срок хранения

6 лет*

* При хранении транзисторов в складских условиях в упаковке поставщика, в ЗИП, а также вмонтированными в аппаратуру, в том числе 1 год в полевых условиях в аппаратуре и ЗИП, защищенных от прямого воздействия радиации и атмосферных осадков.

KT814Б

Граничное напряжение

не менее 40 В

Наибольшее постоянное напряжение коллектор—эмиттер

минус 40 В

Наибольшее постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{BE} \leq 100$ Ом

минус 50 В

Примечание. Остальные данные такие же, как у KT814A.

KT814В

Граничное напряжение

не менее 60 В

Наибольшее постоянное напряжение коллектор—эмиттер

минус 60 В

Наибольшее постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{BE} \leq 100$ Ом

минус 70 В

Примечание. Остальные данные такие же, как у KT814A.

КТ814Г

КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР
p-n-p

КТ814Г

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:

при $t_{кор} = 25 \pm 10$ и $100 \pm 3^\circ\text{C}$
» $t_{кор} = -40 \pm 3^\circ\text{C}$

не менее 30

не менее 20

не менее 80 В

Границочное напряжение

Наибольшее постоянное напряжение коллектор—
эмиттер

минус 80 В

Наибольшее постоянное напряжение коллектор—
эмиттер при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом

минус 100 В

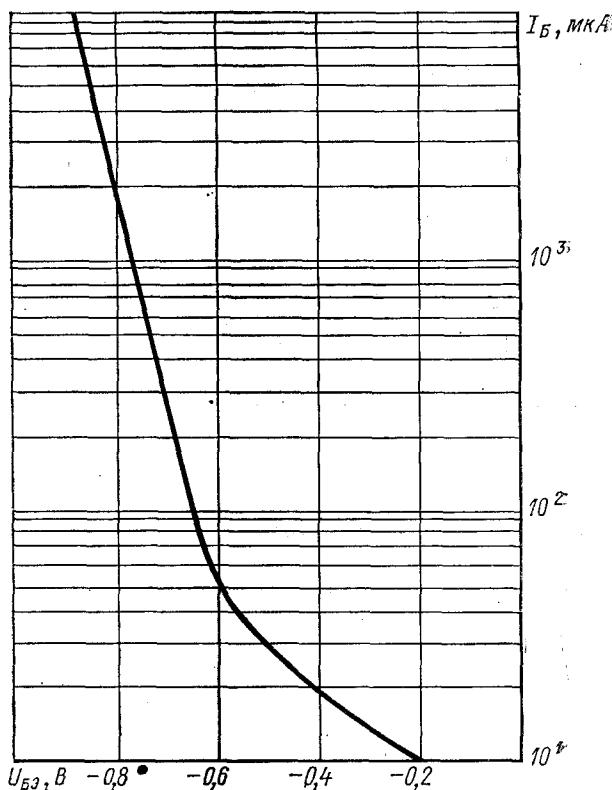
П р и м е ч а н и е. Остальные данные такие же, как у КТ814А.

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
р-п-р

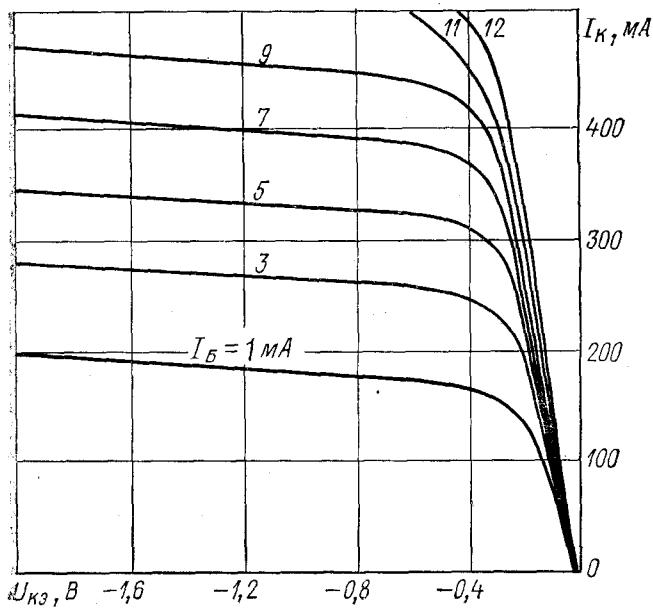
KT814А KT814В
KT814Б KT814Г

ТИПОВАЯ ВХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
(в схеме с общим эмиттером)

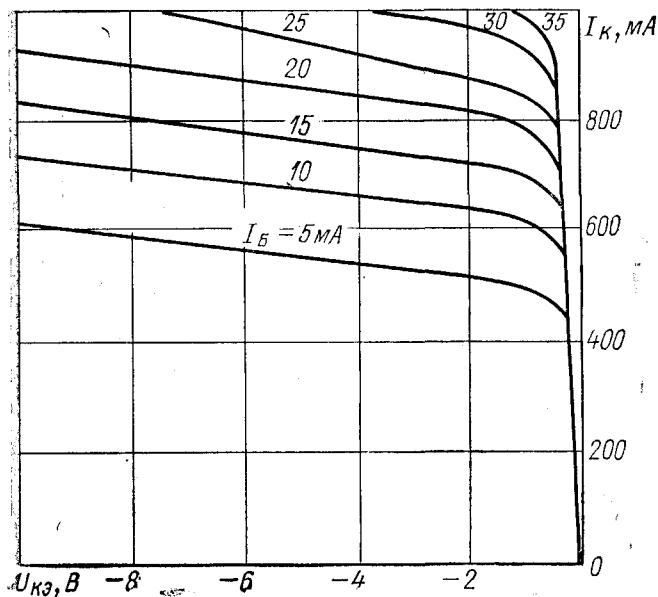
При $U_{K\Theta} = -2$ В



НАЧАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ТИПОВЫХ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
(в схеме с общим эмиттером)



ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(в схеме с общим эмиттером)

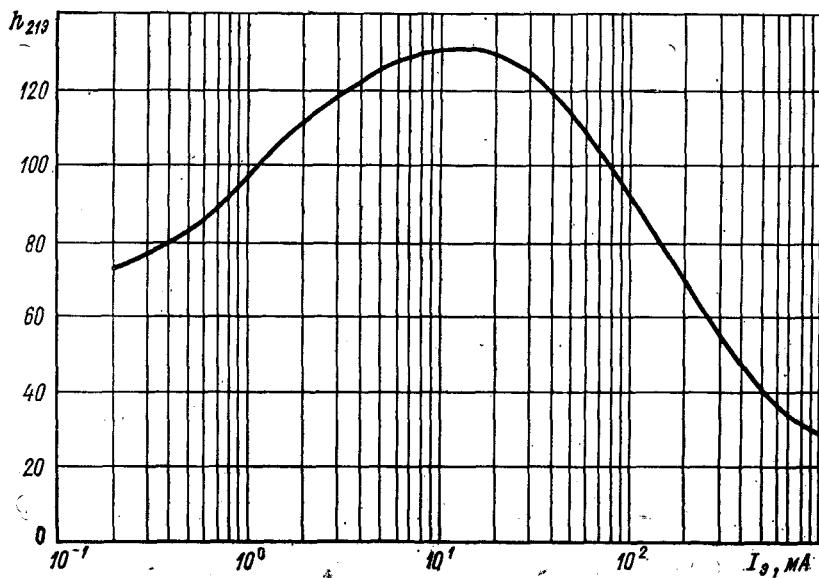


КТ814А КТ814В
КТ814Б КТ814Г

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
р-п-р

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТОКА ЭМИТТЕРА

При $U_{KB} = -2$ В

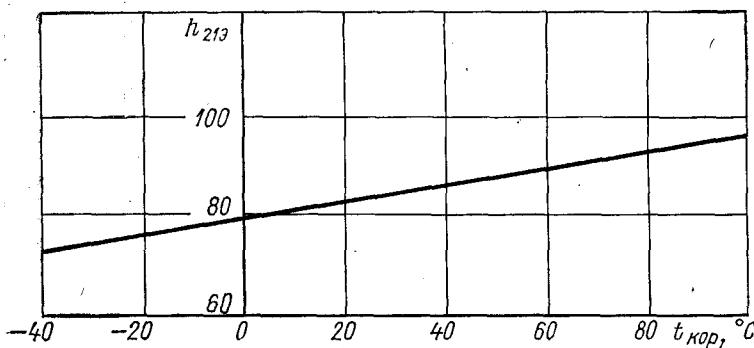


КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
р-п-р

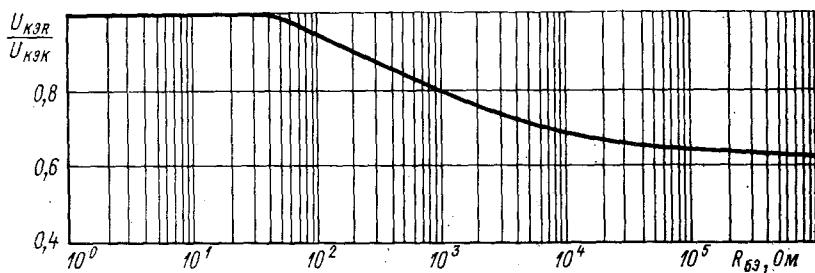
КТ814А КТ814В
КТ814Б КТ814Г

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕДАЧИ ТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРПУСА

При $U_{KB} = -2$ В и $I_E = 150$ мА

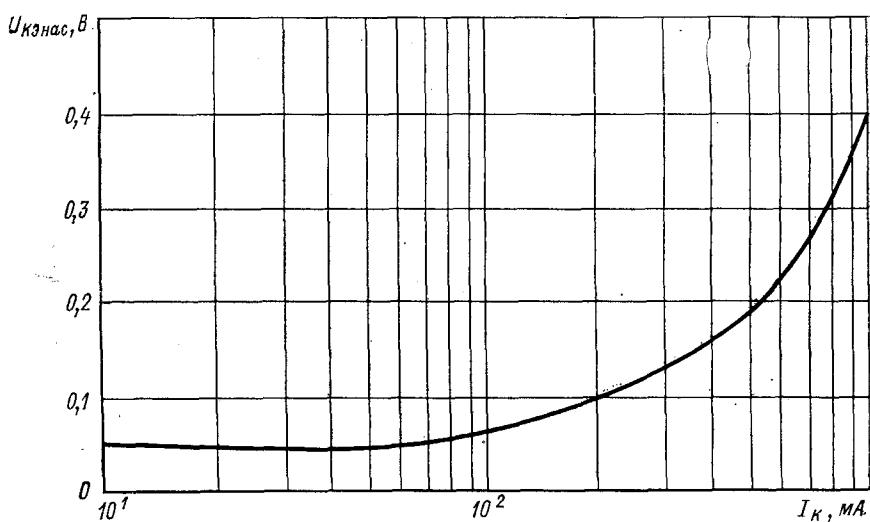


ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОР—ЭМИТТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ ЭМИТТЕР—БАЗА



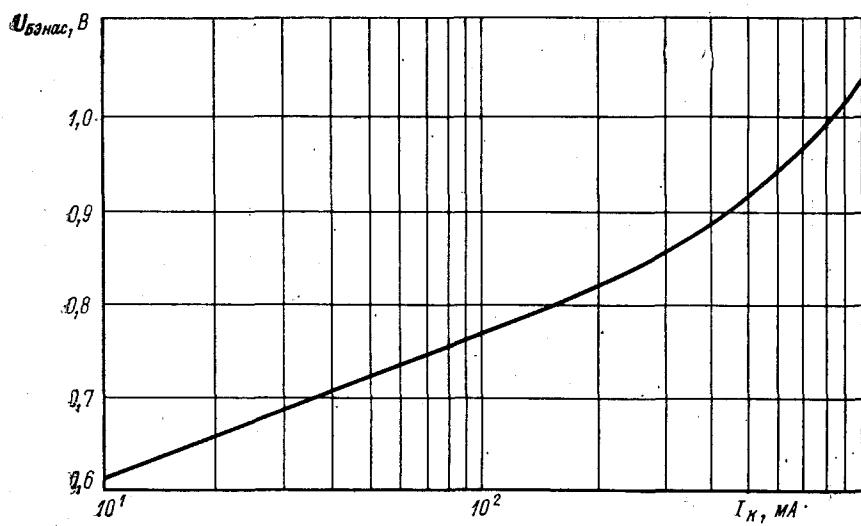
ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ
КОЛЛЕКТОР—ЭМИТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА

При $\frac{I_K}{I_B} = 10$



ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ
БАЗА—ЭМИТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА

При $\frac{I_K}{I_B} = 10$



ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАТНОГО ТОКА КОЛЛЕКТОРА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРПУСА

При $U_{KB} = -40$ В

